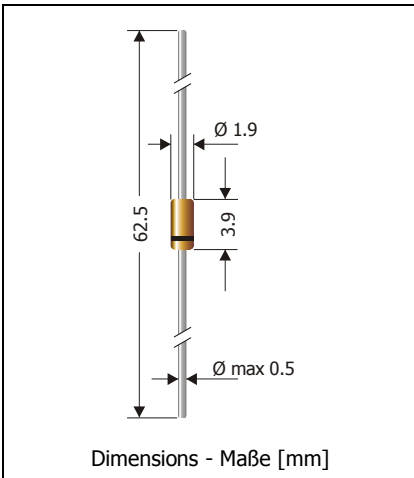


**HZ9LA2 (400 mW)**  
**Silicon Planar Zener Diodes for Low Noise Application**  
**Silizium-Planar-Zener-Dioden mit niedrigem Rauschen**

Version 2012-06-21



Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	400 mW
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung	7.9...8.3 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g

Standard packaging taped in ammo pack  
 Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack



**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

		<b>HZ9LA2</b>	
Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	400 mW <sup>1)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-55...+175°C -55...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{\text{thA}}$	375 K/W

Zener voltages see table below – Zener-Spannungen siehe Tabelle unten

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Zener voltage <sup>2)</sup> Zener-Spannung <sup>2)</sup> $I_z = 0.5 \text{ mA}$		Dynamic resistance Diff. Widerstand $r_{zj} [\Omega]$ at $f = 1 \text{ kHz}$	Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 1 \mu\text{A}$	Z-current <sup>2)</sup> Z-Strom $T_A = 25^\circ\text{C}$
	$V_{z\text{min}} [\text{V}]$	$V_{z\text{max}} [\text{V}]$				
HZ9LA2	7.9	8.3	60	+4...+7	> 6	48

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden  
 2 Tested with pulses  $t_p=20\text{ms}$ – Gemessen mit Impulsen  $t_p=20\text{ms}$